





INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

130	ATENT COOPERATION TRE	
anslation internation	PCT	
INTERNATI	ONAL PRELIMINARY EXAMIN	ATION REPORT
	(PCT Article 36 and Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTION See Noting	fication of Transmittal of Internation Examination Report (Form PCT/IPEA/410
FTA0301-PCT International application No.	International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
PCT/JP2003/007700	18 June 2003 (18.06.2003)	18 June 2002 (18.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or a C04B 35/56, 37/00		
Applicant	KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA	
This report is also accompanies amended and are the basis if 70.16 and Section 607 of the These annexes consist of a section 507. These annexes consist of a section 507 of the These annexes consist of a section 507. Basis of the report Priority III Priority III Non-establishment VIII Reasoned stateme citations and explosure of the Certain document VIII Certain defects in Certain defects in the section 500 of the section 500	t of opinion with regard to novelty, inventive nvention ent under Article 35(2) with regard to novelty lanations supporting such statement	etion, claims and/or drawings which have be cations made before this Authority (see R.).
Date of submission of the demand	Date of completi	on of this report
12 December 2003 (12	2.12.2003)	6 August 2004 (06.08.2004)
Name and mailing address of the IPEA/J	P Authorized office	er
1		

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internation application No.

PCT/JP2003/007700

	of the rep				
. With r	regard to	he elements of the internation	al application:*		
	the intern	national application as original	lly filed		
\boxtimes	the descr	iption:			
لاحا			1-4, 6-32		· , as originally filed
	pages				, filed with the demand
	pages	5, 5/1		, filed with the letter of	12 April 2004 (12.04.2004)
K7	-				
\boxtimes	the clain		1-15, 17-3	2	, as originally filed
				1 1 (1	with any statement under Article 19
	pages _				, filed with the demand
	pages	16		filed with the letter of	12 April 2004 (12.04.2004)
	pages _			_, 1100	
\boxtimes	the drav	rings:			oc originally filed
	pages		1-12		, as originally filed , filed with the demand
	pages				, med with the demand
	pages			_, filed with the letter of _	
	the seave	nce listing part of the descripti	on:		
<u> </u>	pages '				, as originally filed
	pages				, filed with the demand
	pages			filed with the letter of	
the i	the land the land or 55.3 the regard diminary endingering furnish furnish The subsent	al application was filed, unlest were available or furnished guage of a translation furnished guage of publication of the integrate of the translation furnished and/or examination was carried out or med in the international application with the international application was expected out or med in the international application with the subsequently to this Authorited subsequently to this Authorited subsequently to this Authorited application as filed has tatement that the information furnished.	amino acid sequence the basis of the sequence the basis of the sequence ation in written form. The purposes amino acid sequence the basis of the sequence ation in written form. The purposes amino acid sequence the basis of the sequence ation in written form. The purpose acid sequence ation in written form. The purpose acid sequence ation in written form. The purpose acid sequence acid in computer readantly furnished written is been furnished. The recorded in computer recorded in computer to the purpose acid in computer to the purp	the following language	ais Authority in the language in which is: Tule 23.1(b)). The examination (under Rule 55.2 and/ ational application, the international application of go beyond the disclosure in the last to the written sequence listing has
5	This rebeyon	d the disclosure as filed, as inc	if (some of) the amend	Office in response to an inte	since they have been considered to g itation under Article 14 are referred t not contain amendments (Rule 70.1
	<i>a 70 17</i>)	ment sheet containing such an			



International application No.
PCT/JP03/07700

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
1. Statement					
. Novelty (N)	Claims	1-22	YES		
٠	Claims		NO ·		
Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES		
	Claims	19-22	NO NO		
Industrial applicability (IA)	Claims	1-22	YES		
	Claims		NO		

2. Citations and explanations

Document 4: JP 9-20572 A (Kabushiki Kaisha Toshiba) January 21, 1997

Document 5: JP 2002-37682 A (Toshiba Ceramics Co., Ltd.) February 6, 2002

Document 6: JP 6-293575 A (Toshiba Ceramics Co., Ltd.) October 21, 1994

Document 7: JP 55-3384 A (Norton Co.) January 11, 1980 (particularly, page 3, upper left column)

& GB 2022490 A

Document 8: JP 3-83870 A (Daihen Corporation) April 9, 1991

Claims 19-22

Based on the descriptions in documents 4-8, the inventions of claims 19-22 lack an inventive step. Document 7 describes a method for bonding multiple silicon carbides into a single unit that can be used for forming composite formed products, and describes as prior art technology in which silicon carbide parts are bonded together by first placing carbon between two or more parts in the form of a paste of flour, carbon, charcoal and casein glue; heating in the place the paste to form a carbon skeleton; and, exposing the carbon skeleton to silicon at a temperature of at least 1800 °C. It also states that the silicon impregnates the carbon skeleton forming a silicon carbide and silicon weld or joint.

Document 8 is a method for electrically bonding mutual ceramic members of silicon carbide that contain metallic silicon, and describes a means by which metallic silicon is removed from the butting surfaces of the ceramic members beforehand to make the surfaces porous.

特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70] RECEIVED 2 6 AUG 2004

WIPO PCT

の書類記号 FTA0301-PCT		全報告の送付通知(様式PCT/416)を参照すること。					
国際出願番号 PCT/JP03/07700 国際出願日 (日.月.年) 18.06.2003 (日.月.年) 18.06.2002							
国際特許分類 (IPC) Int. C	国際特許分類 (IPC) Int. Cl. C04B35/56, 37/00						
出願人(氏名又は名称)	株式会社東芝	•					
2. この国際予備審査報告は、この表紀 区の国際予備審査報告には、関 査機関に対してした訂正を含む							
(PCT規則70.16及びPCT この附属審類は、全部で 4							
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 I 図 国際予備審査報告の基礎 II							

国際予備審査の請求書を受理した日 12.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 06.08.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP)	特許庁密査官(権限のある職員)	4 T	8 8 2 1
郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	板谷 一弘		
	電話番号 03-3581-1101 内	線 34	164

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/07700

I.	E	国際予備審査報	設告の基礎				
1.	F	この国際予備。 応答するために P C T規則70.	に提出され	た差し替え用紙は、	, づいて作成され この報告書にお	にた。(法第6条(PC らいて「出願時」とし、	T14条)の規定に基づく命令に 本報告書には添付しない。
		出願時の国際	禁出願審類	• ! !			
	×	明細書	第 第	1-4, 6-32 5, 5/1	ページ、	出願時に提出されたも 国際予備審査の請求告 12.04.2004	
	×	請求の範囲	第	1-15, 17-22		出題時に提出されたも	
		請求の範囲	第		項、	PCT19条の規定に	基づき補正されたもの
		・請求の範囲	第	10		国際予備審査の請求書	
		請求の範囲	第	16	坦、	12. 04. 2004	_ 付の書簡と共に提出されたもの
	×	図面	第	1-12		出願時に提出されたも	
		図面	第	· .	_ ページ/図、	国際予備審査の請求書	と共に提出されたもの
		図面	第		_ ページ/図、		_ 付の書簡と共に提出されたもの
		明細書の配列	別妻の部分	第	ページ	出題時に提出されたもの	<i>-</i>
		明細書の配列	列表の部分	第	ーー ページ、	国際予備審査の請求書	
		明細苷の配列	引表の部分		ページ、		_ 付の書簡と共に提出されたもの
2.		上記の書類は、	下記の言		語である		
	ř			にいう国際公開の言	-	御叭入り日曜	·
	ŗ					、 は55.3にいう翻訳文の電	을 문제
	Ł	— HENT NO.	街息いた	MCMEHICAUNCI O.	1 7 % (1000 . 2 4 . 1 . 1	よ30.31にV・ソ 御加入スマン 6	3 届3
3.	Z	の国際出願に	ま、ヌクレ.	オチド又はアミノ酸	配列を含んでお	り、次の配列表に基づ	き国際予備審査報告を行った。
	ſ		د ک جانعتان	to the section of the section of			
	L			まれる書面による配列 - セルカンス			
	□ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表						
	ļ					出された魯面による配列	
	Ļ					出された磁気ディスクに	
	L			計面による配列表が と	出願時における[国際出願の開示の範囲を	と超える事項を含まない旨の陳述
	Г	書の提出:		・記載した配列と磁気 ・記載した配列と磁気	ラディスクにより	ス節列楽に印録した節気	川が同一である旨の陳述書の提出
l	L	があった。	0 AD/ 100		(1) 1 // / (Ca.		1991年である日の深近街の近日
4.	一補			が削除された。	•	*	
	\dashv	明細音		***			
1	\dashv						
1	ٺ	図面	図面の第			ページ/[图
5.		れるので、そ	その補正が、	は、補充棚に示した されなかったものと 際に考慮しなければ	して作成した。	(PCT規則70.2(c) :	範囲を超えてされたものと認めら この補正を含む差し替え用紙は上
					•		

国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/07700

V. 新規性、進歩性又は産業上の利力 文献及び説明	用可能性についての法 	第 1 2条 (PCT 3 5条(2)) に定める 	見解、それを裏付ける
1. 見解			
新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲	1-22	
進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲	$\frac{1-18}{19-22}$	有 無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲	1-22	
文献5:JP 2002- 2.06 文献6:JP 6-293 21 文献7:JP 55-3	72 A (株式: 37682 A 575 A (東 384 A (ノ	会社東芝)1997.01. (東芝セラミックス株式会社 芝セラミックス株式会社)1 ートン・カンパニー)198 22490 A 式会社ダイヘン)1991.	994.10.
文献7には、複雑な形 コンを一体に接合する方 にかわなどのペーストの 熱して炭素基材を形成し コンに曝露する方法が近 れて炭化シリコンとの	状物を形成するが 法でとして、 とで2個でしいとので でしてといるで 大夫がといるで 大きないとので でもまする。	明は、文献 4~8 から進歩性のに使用することを表しまる炭、 炭素を関いを表別でで、大場で、 炭素がの間に配置しまでで、大場でで、大場ででは、 の間に配置しますがである。 では、では、では、 のでは、では、 ので	およびカゼイン イでペーストを加り での温度でシリ 素基材が含浸さ

本発明の炭化ケイ素基複合材料の製造方法は、さらに前記シリコンの含浸工程で、前記炭化ケイ素粉末から構成され、平均結晶粒径が 0.1~10 μm の範囲の炭化ケイ素結晶粒を有する第 1 の炭化ケイ素相と、前記炭化ケイ素粉末と前記シリコンとの反応により生成され、平均結晶粒径が 0.01~2μm の範囲の炭化ケイ素結晶粒を有する第 2 の炭化ケイ素相とを備える炭化ケイ素マトリックスを形成しつつ、前記炭化ケイ素マトリックスを構成する前記炭化ケイ素結晶粒の隙間にシリコン相をネットワーク状に連続して存在させることを特徴としている。

5

10

15

20

25

また、本発明の第1の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法は、平均 粒子径が 0.1~10 μ m の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1 μ m の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、所望形状の成形体に成形する 工程と、前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成 形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる 焼結体を作製する工程と、前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して 部品とする工程とを有することを特徴としている。

本発明の第2の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法は、平均粒子径が 0.1~10μm の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1μm の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、最終寸法より大きい予備成形体に成形する工程と、前記予備成形体の少なくとも一部を生加工して、前記予備成形体の寸法よりは小さくかつ前記最終寸法よりは大きい寸法を有する成形体に加工する工程と、前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる焼結体を作製する工程と、前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して部品とする工程とを有することを特徴としている。

本発明の第1および第2の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法によれば、複雑な形状や大型の各種部品を、強度や靱性などに優れる炭化ケ

イ素基複合材料で安価に製造することが可能となる。すなわち、本発明

前記シリコン相を前記複合材料に対して 5~50 質量%の範囲で存在させることを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

- 12. 請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、 前記成形工程で、前記混合粉末を含むスラリーを0.5~10MPaの加圧下
- 5 で鋳込み成形することを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。
 - 13.請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、 前記成形工程で、前記混合粉末を 0.5~2MPa の加圧下で加圧成形する ことを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。
 - 14. 請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、
- 10 前記シリコンの含浸工程で、1400℃以上に加熱した前記成形体に減圧 下または不活性雰囲気下で前記溶融したシリコンを含浸させることを特 徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

15

20

15. 平均粒子径が 0.1~10 μ m の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1 μ m の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、所望形状の成形体に 成形する工程と、

前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる焼結体を作製する工程と、

前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して部品とする工程とを有することを特徴とする炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法。

16. (補正後) 平均粒子径が 0.1~10μm の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1μm の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、最終寸法より大きい予備成形体に成形する工程と、

前記予備成形体の少なくとも一部を生加工して、前記予備成形体の寸 25 法よりは小さくかつ前記最終寸法よりは大きい寸法を有する成形体に加 工する工程と、 前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.